

SiCパワー半導体 生産能力拡大に向けて 新たな生産拠点を取得（予定）

2023年7月12日

ローム株式会社

SiC事業のキャパシティ増強計画

NEW

宮崎(国富)



4th FAB
取得に向けて基本合意

ローム・アポロ 筑後

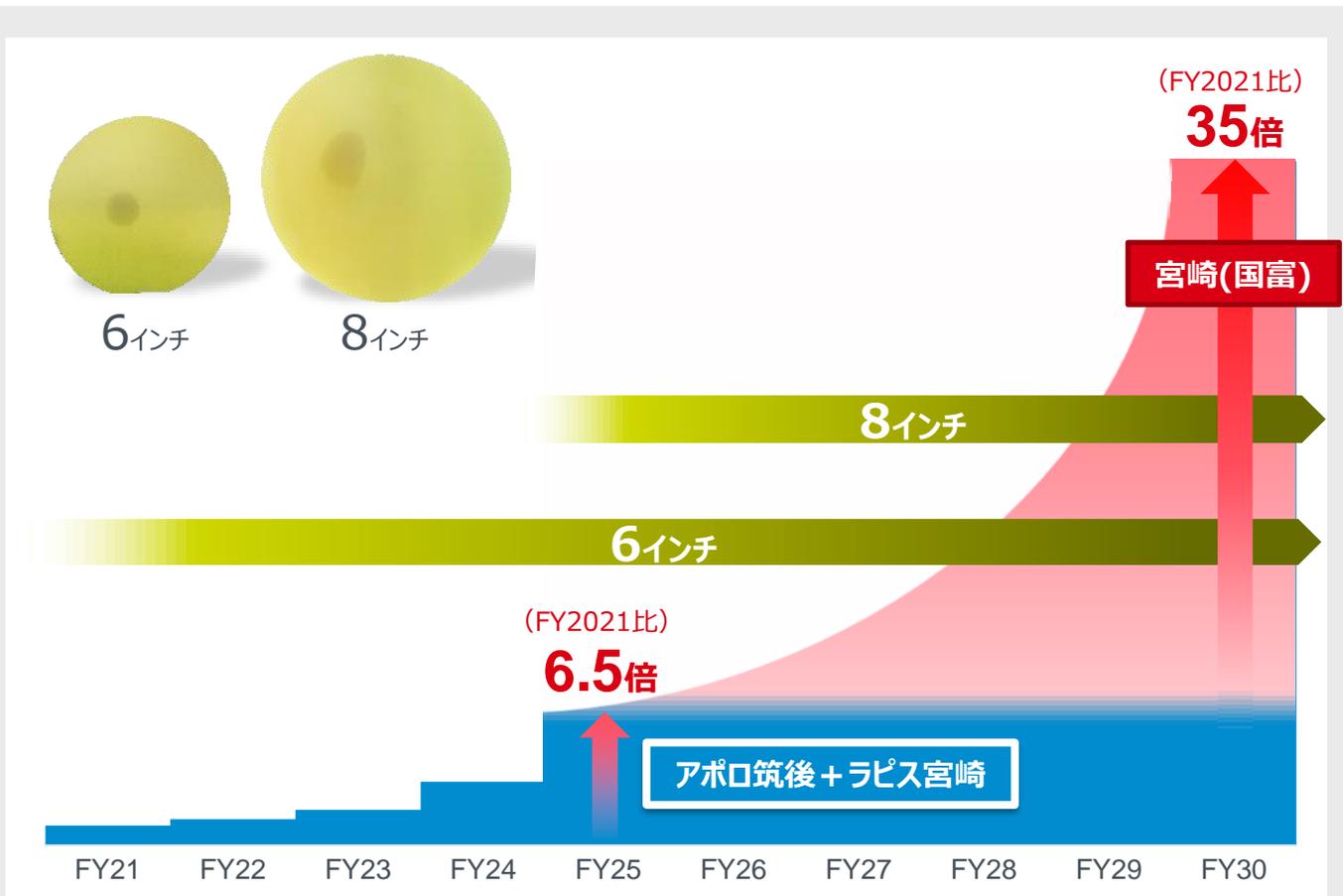
3rd FAB (新棟)
・2022年12月より量産開始
・6インチから8インチウエハへの変換が可能な設備を導入



1st FAB (既存棟)

ラピス 宮崎

2nd FAB
・2021年より第4世代 SiC-MOSFETの量産開始





所在地：宮崎県東諸県郡国富町田尻1815

敷地面積：約40万㎡（東京ドーム8個分）

建物面積：約23万㎡

建物概要：生産棟、物流倉庫、事務所など

◆既存建物やクリーンルームを活用することで早期生産立ち上げが可能。
早ければ**2024年末の稼働を目指す。**

◆2030年までのSiC生産能力をカバー見込。**SiC生産能力は35倍（2021年比）**